

KD1366



シリコンフォトダイオード

Silicon Photo Diode



概要 Description

KD1366 は、プレーナータイプのシリコン・フォトダイオードチップを表面実装型パッケージに組み込んだフォトダイオードです。

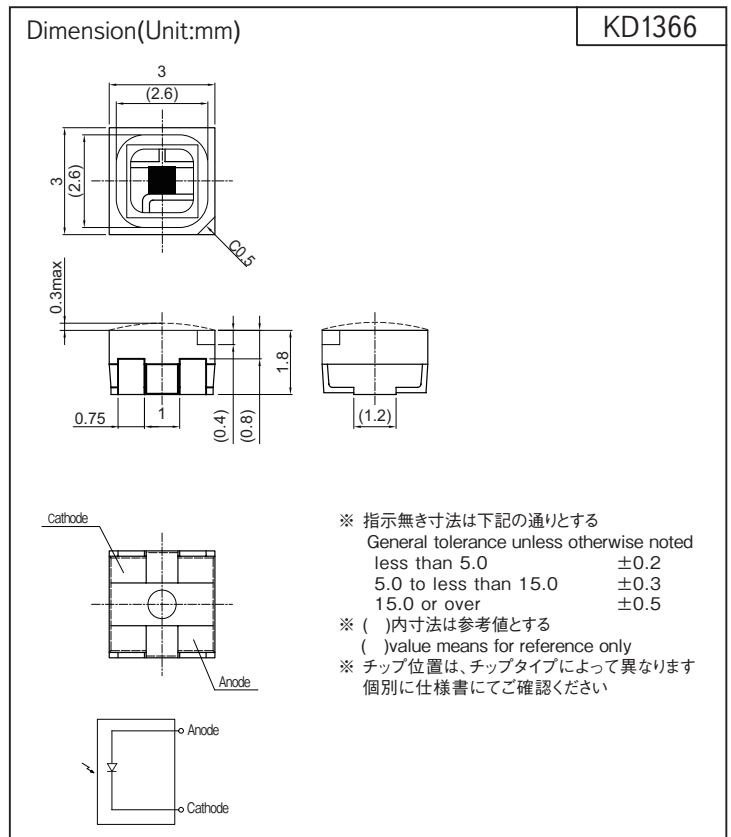
Model KD1366 is silicon photodiode mounted in Surface mount package.

特長 Feature

- ・ 高感度フォトダイオード (λ p:900nm)
- ・ Photo diode (λ p:900nm)

用途 Application

- ・ 紙幣のパターン読み取り用受光素子
- ・ 紙幣パターン識別用受光素子
- ・ Photo detector for Bill validator
- ・ Photo detector for printing discrimination



最大定格 Maximum Ratings [Ta=25°C **]

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse Voltage	VR	30	V
許容損失 Power Dissipation	Pd	100	mW
動作温度 Operating Temperature	Topr	-20 ~ +85	°C
保存温度 Storage Temperature	Tstg	-30 ~ +95	°C
半田付温度 Soldering Temperature ※1	Tsol	260	°C

- ※ 1. 無鉛リフロー半田
- ※ 2. EV : CIE 標準 A 光源

- ※ 1. Reflow process required
- ※ 2. EV : CIE STD. A Light source

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Ta=25°C **]

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
暗電流 Dark Current	ID	VR=10V, EV=0 lx ※2	—	—	10	nA
短絡電流 Short Circuit Current	ISC	EV=1000 lx ※2	0.5	—	—	μA
ピーク感度波長 Peak Wavelength	λp	—	—	900	—	nm
指向角半値幅 Half Angle	Δθ	—	—	±60	—	deg
応答時間 Response Time	上昇 Rise Time	VR=5V, RL=1kΩ	—	3	—	μs
	下降 Fall Time		—	3	—	

** : Ta=25°C unless otherwise noted

KD1366

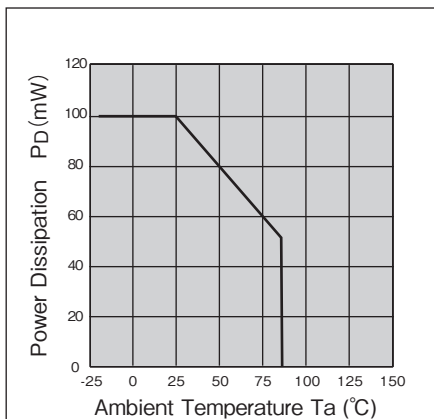
定格・特性曲線

※注意 最大定格を超えないようにご使用ください

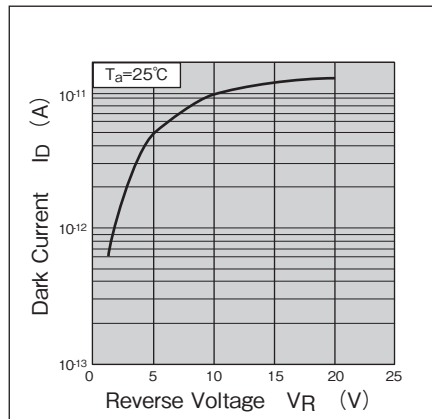
Characteristics

Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

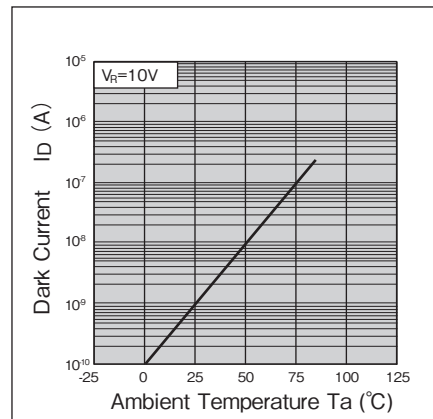
許容損失低減曲線



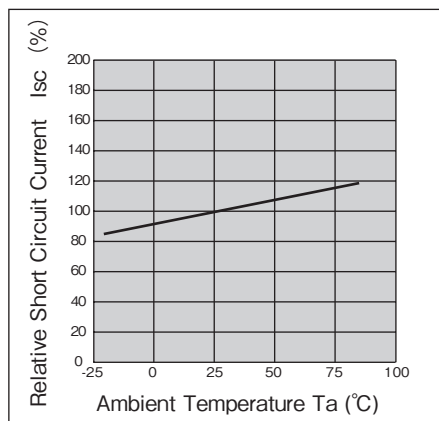
暗電流—逆電圧特性(代表例)



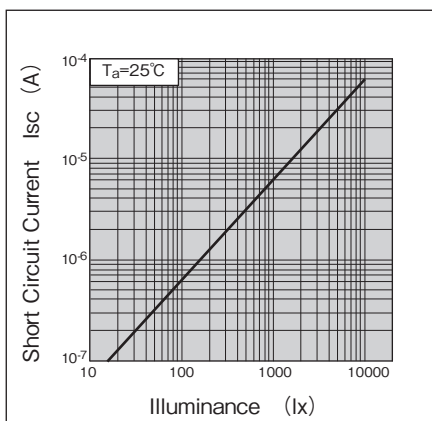
暗電流—周囲温度特性(代表例)



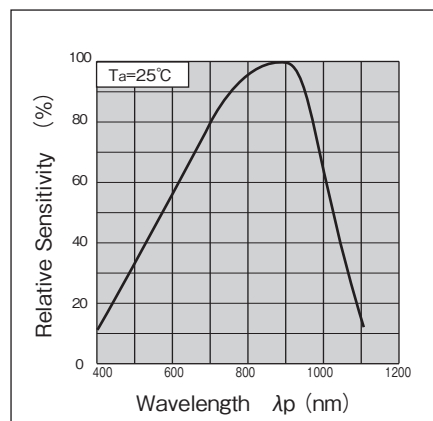
短絡電流—周囲温度特性(代表例)



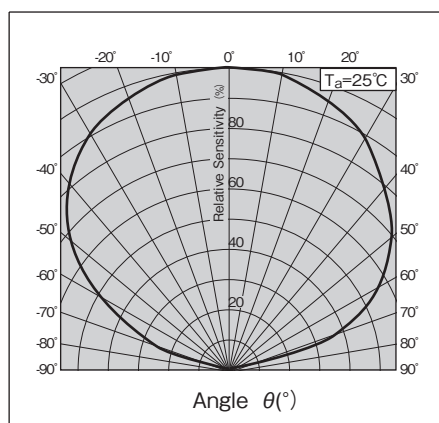
短絡電流—照度特性(代表例)



分光感度特性(代表例)



指向特性(代表例)



- ・ カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・ この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- ・ A Customized design available on request.
- ・ Specifications are subject to change without notice.

お問合せ先：新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics Co., Ltd.

shinkoh-elecs

www.shinkoh-elecs.jp